

60r

pot
200r

33pf

180r

180r

33pf

4pf7

60r

1pf8

1pf2

39pf

39pf

2pf7

3 x 1pf5

2xD
Sili.

HRF9260 23cm
F6BVA 10/2012
R04003 / 0.8mm

100
35V

100
35V

SSPA 23cm MRF8S9260.

Nomenclature pour un étage.

Désignation	Valeur	Commentaires
Q1	MRF8S9260	
D1,D2	Diode silicium1A	Pas critique
D3	BAT15	Mesure facultative
D4	Zener 6V8/8v2	Pas sur les images mais mettez-la!
IC1	78L05 par exemple	
C1,C2	10 μ f25V	
C3, C4,	39Pf ATC100B	
C5, C7, C13	33pf ATC100B	
C6, C9, C10, C11, C14, C18, C19	100nf 50V	
C8,C11, C12, C17	1nf 50v	
C15, C16	100 μ f 35V mini	50V mieux!
R1	47ohms	Mesure facultative
R2	Pot 200ohms	Multi-tours de preference
R3, R5	57 ohms	
R4, R6	180ohms	
Les capas d'adaptations	Toutes ATC100B	Voir valeur et position sur photo. !!!

REF 457.1 W
2 dB/
LOF

A_Write B_Blank MKR 28.95 ms
237.6 W

Mon 17 Nov 2014 10:49

REF LEVEL
457.1 W



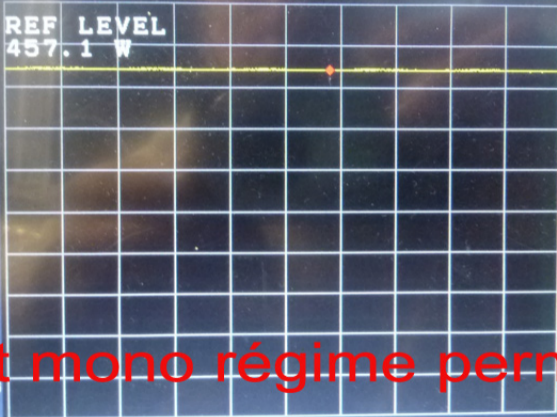
Level
dB/div
Linear
Units
Ref Offset
 ON OFF

Out mono pulse 10%

CENTER 1.296200000 GHz SPAN 0 Hz
*RBW 5 MHz *VBW 5 MHz SMP 50 ns ATT 20 dB

Mon 17 Nov 2014 10:51
REF 457.1 W A_Write B_Blank MKR 28.95 ms
2 dB/ 221.4 W
LOF

REF LEVEL
457.1 W



Swp Time
Swp Time
AUTO MR

Out mono régime permanent

CENTER 1.296200000 GHz SPAN 0 Hz
*RBW 5 MHz *VBW 5 MHz SWP 50 ms ATT 20 dB

All Auto

02WY
100
35V

MRF8S9260H
001128C

05E
001
AM12

MRF9260 23cm
F6BVA 10/2012
R04003 / 0.8mm

10-25
R8

10-
R8

↻